METHOD OF MANUFACTURING FINE PARTICLES AND MANUFACTURING DEVICE FOR THE SAME

Publication number: JP2003012377
Publication date: 2003-01-15

Inventor:

OKANO KAZUYUKI; SHIMADA MIKIYA; SHIRAISHI

SEIGO: TAI NOBUYUKI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international: B02C19/06; B02C23/28; B02C23/32; C04B35/46;

C04B35/628; H01G4/12; H01G4/30; H01M4/04; H01M4/58; H05K3/46; C04B35/46; B02C19/06; B02C23/18; C04B35/46; C04B35/626; H01G4/12; H01G4/30; H01M4/04; H01M4/58; H05K3/46; C04B35/46; (IPC1-7): C04B35/46; C04B35/628; B02C19/06; B02C23/28; B02C23/32; H01G4/12; H01G4/30; H01M4/04; H01M4/58; H05K3/46

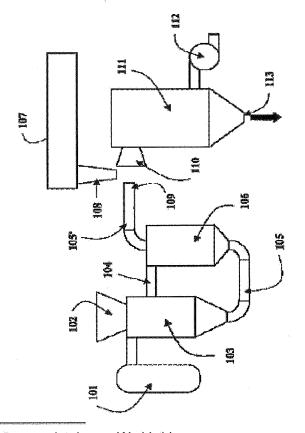
- european:

Application number: JP20010196032 20010628 Priority number(s): JP20010196032 20010628

Report a data error here

Abstract of JP2003012377

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture the fine particles which are uniform in grain shape having sharp distribution curve of grain diameters, and also to provide an electronic device little in characteristic dispersion and good in manufacturing yield. SOLUTION: The grains of fine particles are manufactured in a way that each grain is heat treated effectively by continuously irradiating laser microwave while crushing, scattering and classifying in the air flow. The electronic device can be manufactured with a good yield, having stability in the distribution of grain size, in the shape, and in the surface state, by using the fine particles manufactured as above described.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-12377 (P2003-12377A)

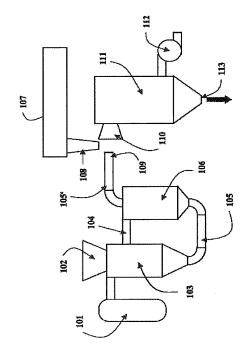
(43)公開日 平成15年1月15日(2003.1.15)

51)Int.Cl. ⁷		FΙ				テーマコート*(参考)		
35/628			В0	2 C	19/06		В	4D067
19/06					23/28			4G030
23/28					23/32			4G031
23/32			Н0	1 G	4/12		358	5 E 0 0 1
4/12	358						361	5 E O 8 2
		審查請求	未請求	請求	項の数32	OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出廢番号 特願2001-196032(P2001		-196032)	(71)	出願丿	0000058	321		
					松下電	器産業	株式会社	
	平成13年6月28日(2001.6.	28)	大阪府門真市大字門真1006番地				番地	
			(72)	発明者	首 岡野	和之		
					大阪府	門真市	大字門真1006	番地 松下電器
					産業株	式会社	内	
			(72)	発明者	輸田	幹也		
					大阪府	門真市	大字門真1006	潘地 松下電器
					産業株	式会社	内	
			(74)	代理人	100097	445		
					弁理士	岩橋	文雄 (外	2名)
								最終頁に続く
1	19/06 23/28 23/32	19/06 23/28 23/32 4/12 3 5 8 特願2001-196032(P2001-	19/06 23/28 23/32 4/12 3 5 8	19/06 23/28 23/32	19/06 23/28 23/32 H 0 1 G 4/12 3 5 8 審査請求 未請求 請求 特願2001-196032(P2001-196032) (71)出願ノ 平成13年6月28日(2001.6.28) (72)発明者	23/28 23/32 4/12 3 5 8 審査請求 未請求 請求項の数32 特願2001-196032(P2001-196032) (71)出願人 000005 松下電 平成13年 6 月28日(2001. 6. 28) (72)発明者 岡野 大阪府 産業株 (72)発明者 嶋田 大阪府 産業株 (74)代理人 100097	23/28 23/32 23	23/28 23/32 4/12 3 5 8

(54) 【発明の名称】 粉体製造方法および粉体製造装置

(57)【要約】

【課題】 粒子形状の揃った粒径分布のシャープな粉体を製造することと、その原料粉体を用いて特性バラツキが小さく、製造歩留りの良い電子デバイスを提供する。 【解決手段】 粉砕、分散、分級を気流中で行うと共に、連続してレーザかマイクロ波を照射して、粉体粒子1つずつを効率良く加熱処理することにより、粒度分布、形状、表面状態等の安定した粉体を製造し、これを用いることによって製造歩留りの良い電子デバイスが製造できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】粗粉砕した粉体を微粉砕し、該微粉砕した 粉体を乾式気流法で分級して所定の粒径範囲の粉体を取 り出し、前記所定の粒径範囲以上の粉体を再び前記微粉 砕する工程に戻し、前記所定の粒径範囲に分級した粉体 を気流で搬送しながら加熱した後冷却し、該加熱、冷却 した粉体を集めることを特徴とする粉体製造方法。

【請求項2】粗粉砕した粉体を微粉砕する際、高速気流中で粉体を搬送し、硬質板状体に衝突させるか、或いは、粉体を搬送する高速気流を対向して配置することに 10より、粉体同士を衝突させて微粉砕することを特徴とする請求項1に記載の粉体製造方法。

【請求項3】分級した粉体を気流で搬送しながら加熱する際、レーザ光の照射によって加熱することを特徴とする請求項1に記載の粉体製造方法。

【請求項4】照射するレーザ光が、炭酸ガスレーザもしくはYAGレーザであることを特徴とする請求項3に記載の粉体製造方法。

【請求項5】分級した粉体を気流で搬送しながら加熱する方法が、マイクロ波加熱法であることを特徴とする請 20 求項1 に記載の粉体製造方法。

【請求項6】乾式気流法で分級して所定の粒径範囲の粉体を取り出し、前記所定の粒径範囲に分級した粉体を気流で搬送しながら加熱した後冷却する際に、不活性ガス気流中で行うことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の粉体製造方法。

【請求項7】高速気流式分級機から排出される気流中に 含まれる粉体にレーザ光を照射して、該照射による加熱 処理にて得られた粉体を乾式微粉捕集装置にて補集する ことを特徴とする粉体製造装置。

【請求項8】高速気流式分級機から排出される気流中に 含まれる粉体をマイクロ波により加熱して、該加熱処理 により得られた粉体を乾式微粉捕集装置にて補集するこ とを特徴とする粉体製造装置。

【請求項9】高速気流式粉砕機と高速気流式分級機を連結もしくは合体させ、これらに、該分級機から排出される気流中に含まれる粉体にレーザ光を照射する手段を連結し、該照射による加熱処理にて得られた粉体を、前記分級器に連結された乾式微粉捕集装置にて補集することを特徴とする粉体製造装置。

【請求項10】高速気流式粉砕機と高速気流式分級機を連結もしくは合体させ、これらに、該分級機から排出される気流中に含まれる粉体をマイクロ波により加熱する手段を連結し、該加熱処理にて得られた粉体を、前記分級器に連結された乾式微粉捕集装置にて補集することを特徴とする粉体製造装置。

【請求項11】高速気流式分級機から排出される気流が不活性ガスであることを特徴とする請求項7から請求項10のいずれか1項に記載の粉体製造装置。

【請求項12】セラミック組成物を仮焼した後、粗粉砕

するかもしくは微粉砕し、請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理してなるセラミック原料粉末を、樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてスラリーもしくはペーストを製造し、該スラリーを塗布乾燥してグリーンシートを形成し、配線、電極を具備して、積層、脱バインダ、焼成し、該ペーストを印刷して乾燥した後、脱バインダ、焼成して製造することを特徴とするセラミック電子部品。

【請求項13】平均粒子径が0.3ミクロン未満のチタン酸バリウム粉末を、請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理した後、微量添加物として他の酸化物粉末を混合するかもしくは該酸化物を構成する金属を含有する前駆体を混合して処理することによって誘電体組成物粉末を製造し、該誘電体組成物粉末を、樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてスラリーとし、該スラリーを塗布して乾燥したグリーンシートと内部電極を具備して積層、脱バインダ、焼成して製造することを特徴とする積層セラミックコンデンサ。

【請求項14】少なくとも1種のガラス形成酸化物を含む酸化物混合物を溶融して急冷するととによりガラス塊を製造し、該ガラス塊を粗粉砕するかもしくは微粉砕し、請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理してなるガラスフリットと、フィラーとして他の酸化物粉末を混合してガラスセラミック組成物粉末を製造し、該ガラスセラミック組成物粉末を、樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてスラリーもしくはベーストを製造し、該スラリーを塗布乾燥してグリーンシートを形成し、配線、電極を具備して、脱バインダ、焼成し、該ベーストを印刷して乾燥した後、脱バインダ、焼成成して製造することを特徴とする多層配線基板。

【請求項15】少なくとも1種のガラス形成酸化物を含む酸化物混合物を溶融して急冷することによりガラス塊を製造し、該ガラス塊を粗粉砕するかもしくは微粉砕し、請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理してなるガラスフリットと、フィラーとして他の酸化物粉末を混合してガラスセラミック組成物粉末を製造し、該ガラスセラミック組成物粉末を、樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてスラリーもしくはベーストを製造し、該スラリーを塗布乾燥してグリーンシートを形成し、配線、電極を具備して、脱バインダ、焼成し、該ベーストを印刷して乾燥した後、脱バインダ、焼成して製造することを特徴とするモジュール部品。

【請求項16】少なくとも1種のガラス形成酸化物を含む酸化物混合物を溶融して急冷することによりガラス塊を製造し、該ガラス塊を粗粉砕するかもしくは微粉砕し、請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理してなるガラスフリットを樹脂バインダを溶解した溶液に分散させて製造したペーストと、前記ガラスフリットと、フィラーとして他の酸化物粉末を混合してガラスセラミック組成物粉末を製造し、該ガラスセラミ

3

ック組成物粉末を、樹脂バインダを溶解した溶液に分散 させて製造したベーストとを、基板上に塗布もしくは印 刷して乾燥した後、脱バインダ、焼成して製造すること を特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項17】蛍光体粉体原料を請求項7から請求項1 1のいずれか1項に記載の装置で処理して、スラリーも しくはペーストを製造し、該スラリーもしくはペースト を塗布もしくは印刷して乾燥した後、脱バインダ、焼成 して製造することを特徴とする請求項16に記載のプラ ズマディスプレイパネル。

【請求項18】フィラーとしての粉体原料を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理することを特徴とする請求項14に記載の多層配線基板。

【請求項19】フィラーとしての粉体原料を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理することを特徴とする請求項15に記載のモジュール部品。

【請求項20】フィラーとしての粉体原料を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理することを特徴とする請求項16に記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項21】少なくとも1種の遷移金属酸化物を含む酸化物混合物を仮焼した後、粗粉砕するかもしくは微粉砕し、請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理してなる複合酸化物粉末と、導電性付与のためのカーボン粉末を混合して、樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてベーストを製造し、該ベーストを金属箔上に塗布、乾燥した後、圧延して極板を製造することを特徴とする電池。

【請求項22】少なくとも1種の遷移金属硫化物を含む硫化物混合物を不活性雰囲気中で仮焼した後、粗粉砕す 30 るかもしくは微粉砕し、請求項11に記載の装置で処理してなる複合硫化物粉末と、導電性付与のためのカーボン粉末を混合して、樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてペーストを製造し、該ペーストを金属箔上に塗布、乾燥した後、圧延して極板を製造することを特徴とする電池。

【請求項23】金属粉末を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理し、該金属粉末を樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてペーストもしくはインクを製造し、該ペーストもしくはインクを配線材或い 40は電極として用いることを特徴とする請求項12に記載のセラミック電子部品。

【請求項24】金属粉末を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理し、該金属粉末を樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてベーストもしくはインクを製造し、該ペーストもしくはインクを配線材或いは電極として用いることを特徴とする請求項13に記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項25】金属粉末を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理し、該金属粉末を樹脂バ 50

インダを溶解した溶液に分散させてペーストもしくはインクを製造し、該ペーストもしくはインクを配線材或いは電極として用いることを特徴とする請求項14または18に記載の多層配線基板。

【請求項26】金属粉末を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理し、該金属粉末を樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてベーストもしくはインクを製造し、該ベーストもしくはインクを配線材或いは電極として用いることを特徴とする請求項15または1019に記載のモジュール部品。

【請求項27】金属粉末を請求項7から請求項11のいずれか1項に記載の装置で処理し、該金属粉末を樹脂バインダを溶解した溶液に分散させてベーストもしくはインクを製造し、該ベーストもしくはインクを配線材或いは電極として用いることを特徴とする請求項16、17、20のいずれか1項に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項28】金属粉末が、ニッケル、銀、バラジウム、銅、金、もしくはそれらの合金であることを特徴と20 する請求項23に記載のセラミック電子部品。

【請求項29】金属粉末が、ニッケル、銀、バラジウム、銅、金、もしくはそれらの合金であることを特徴とする請求項24に記載の積層セラミックコンデンサ。 【請求項30】金属粉末が、ニッケル、銀、バラジウム、銅、金、もしくはそれらの合金であることを特徴とする請求項25に記載の多層配線基板。

【請求項31】金属粉末が、ニッケル、銀、パラジウム、銅、金、もしくはそれらの合金であることを特徴とする請求項26に記載のモジュール部品。

10 【請求項32】金属粉末が、ニッケル、銀、バラジウム、銅、金、もしくはそれらの合金であることを特徴とする請求項27に記載のプラズマディスプレイパネル。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、粉体の製造方法とその設備装置に関するものであり、また、それによって製造した粉体を用いて製造する電子デバイスに関するものであって、粉体製造と電子デバイス製造において利用できるものである。

0 [0002]

【従来の技術】電子機器の小型化、高性能化に伴い、電子デバイスの実装密度をより高くすることが望まれている。それに伴って、例えば表面実装型の積層セラミックコンデンサでは、内部電極の卑金属化や、誘電体層の薄層化および高積層化などによって小型大容量の製品を安価で実現できるようになり、また、基板内にコンデンサやコイル、フィルター等の受動素子を内蔵させたモジュールも実現され、このような高実装密度の要望に応えている。

【0003】これら電子デバイスの多くは粉体原料を用

いて、樹脂バインダの溶液にそれを分散させたスラリー を塗工してグリーンシートを成形したり、或いは同様に ペーストを作成して印刷乾燥した後、脱バインダと焼成 プロセスを経て製造されるのが一般的である。従って、 製造される電子デバイスの特性や信頼性のバラツキに対 して、これらスラリーやペーストのレオロジー的性質の 再現性や、塗工法や印刷法など工法の再現性および製造 したグリーン体の密度や充填度、バインダの分布等の物 性値の再現性が、その後の焼成、焼結工程の再現性と共 に重要な影響を及ぼす。また、各種電子機器に用いる基 10 板用のコンポジット材料や、リチウムイオン電池に代表 される電池の正極や負極の活物質層など、スラリーやペ ーストを塗工して乾燥、硬化等を行い、そのまま使用に 供するような電子デバイスにおいては、前述のような物 性値の管理、制御が、より重要な製造上の品質管理ポイ ントとなる。

【0004】それ故に、例えばチタン酸バリウムや酸化チタン、或いはアルミナ、シリカといった酸化物では、ゾルーゲル法や水熱合成法に代表される液相合成法によって、微細で粒径分布や粒子の形が揃った原料粉体が開20発、製造され、前述のような用途に供されている。また、金、銀、銅、バラジウム及びニッケルなどの金属においても、液相合成法や気相合成法によって同様な原料粉体が製造され、実用化されている。また、セラミック粉末を自由落下させながら炭酸ガスレーザービーム中を通過させ、球状の形が整ったセラミック粉末を製造しようとする試みが、第11回固体イオニックス講演要旨集、pp79(1984)に示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、本質的 な物理化学的性質によって前述のような合成法が適用で きないか、或いはそのような合成法では安価に製造でき ないため、粉体の仮焼法や溶融法によって合成し、それ を機械的に破壊(粉砕)することによって製造せざるを 得ない粉体材料もあり、これらにおいてはブロードな粒 径分布や形状の不規則さ、および表面状態のバラツキ等 に起因すると思われる種々の再現性不良が生じる。例え ば、このような粉体材料の代表的なものとして酸化物ガ ラスフリットが挙げられ、これを原料として製造される 電子デバイス (例えば、ガラスセラミックをベースとし 40 たモジュール部品やブラズマディスプレイパネルなど) においては、スラリーやペーストの再現性不良による工 程不良発生や信頼性不良など、歩留りの低下が起こる。 【0006】コンデンサやバリスタ、フィルター等に代 表されるセラミック部品の製造においては、それぞれの 所望の特性を発現させるために主成分に対して数種の添 加成分を加えるのが一般的であるが、これらの反応を均 一に起こさせ、さらに各成分の混合を促進するため、仮 焼、粉砕が行われる。これによって、少なくとも化学成 分的には均一な粉体原料が得られるが、粉砕を行うこと 50

によって前述のガラスフリットと同様な粒子形状、粒径 分布となり、製品特性のバラツキを引き起こす原因となっている。

【0007】また、特に積層セラミックコンデンサでは、性能を向上させるための手段として原料粉末の微細化と焼結体の結晶粒子微細化が重要であるが、制御された化学的製造法によって得られた微細な原料粉末は結晶性が低く、焼成工程においてしばしば異常な粒子成長を起こす。このため、高信頼性でしかも容量の温度特性が良好な製品を実現することが困難である。

【0008】以上のような電子デバイスの構成には電極や配線部分が必須であり、この部分については金属粉末を使用して製造されるのが一般的であるが、安価な金属粉末については特に形状のランダムさが製造される製品の特性やバラツキに大きな影響を与えている。

【0009】電池においては、例えば、リチウムイオン 2次電池の正極活物質としてコバルト酸リチウム等が使 用されるが、これらの粉末は前述のような仮焼、粉砕法 で製造されるのが一般的であるため、粒子形状や大きさ の分布が塗布用スラリー、或いはペーストの物性のバラ ツキに影響を与え、活物質層を形成したときに、導電材 料として混合されるカーボン材料の分布や接触状態が制 御できず、容量やサイクル特性等の製品バラツキとな る。

【0010】また、前述の炭酸ガスレーザビーム中を自由落下させる粉体の製造法では、特に 1μ m以下の微細な粉末粒子が凝集したまま加熱されるため、製造される粉末の粒子径が 1μ m以上であって、粒子径が 10μ m以上の粒子も含まれるような粉体しか製造できないことが明らかにされている。この方法により製造された粉末を分級し、所定の粒子径範囲にある粉末を得るという製造方法も考えられるが、容易に分かるように収率が悪く、コストが上がって不利となる。

【0011】本発明は、このような課題を解決するために考案されたものであって、その目的は、粒子形状の揃った、粒径分布のシャープな粉体を製造することと、その原料粉体を用いて特性バラツキが小さく、製造歩留りの良い電子デバイスを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するため、本発明の粉体製造方法は、粗粉砕した粉体を微粉砕し、該微粉砕した粉体を乾式気流法で分級して設定した粒径範囲の粉体を取り出し、分級して設定した粒径範囲以上の粉体を再び前記微粉砕する工程に戻し、該設定した粒径範囲に分級した粉体を気流で搬送しながら加熱した後冷却し、該加熱、冷却した粉体を集めるという構成とした。

【0013】また、前記微粉砕する際には、高速気流中で粉体を搬送し、硬質板状体に衝突させるか、或いは、 粉体を搬送する高速気流を対向して配置することによ り、粉体同士を衝突させて微粉砕することによって行うが、この工程は実質的に粉砕を行うという意味と、また、他の方法によって既に微粉砕されている粉体に対して、機械的に凝集を解いて気流中に分散させるという意味を持つものである。

【0014】本発明の粉体製造方法で、最も特徴的であ るのは、分散し、分級した粉体を気流で搬送しながら加 熱する際の方法が、レーザ光の照射によるか、或いはマ イクロ波加熱法によって行う構成とした部分である。と れによって任意の粒径範囲に分級された粉体粒の1つ1 つが熱効率良く加熱されると共に、実質的に分級装置の 速度で粉体の処理速度が決まるので、極めて量産性に優 れている。更に、扱うべき物質の性質に応じて加熱方法 や条件を選択することにより、粉体粒1つ1つの結晶性 を高めたり、溶融させて球状化させたりすることができ る。使用するレーザとしては、加熱を主たる目的とする 場合に限っては炭酸ガスレーザかYAGレーザがコス ト、出力等の点で工業的に有利であるが、加熱に伴って 化学反応を起こさせることも目的とする場合には、エキ シマレーザ等のレーザも使用することができ、種々のレ ーザについて期待される効果を同時に実現させるために 複数の異なるレーザを同時に照射させても良い。

【0015】 このように、本発明の構成は、粉体粒子の分散、搬送、加熱を気流中で行うのが特徴であるので、用いる気流としても、通常の大気のみならず不活性ガスでも構成することができるため、酸化性雰囲気中での加熱によって変質するような物質の粉体であっても処理することができる。

【0016】本発明の粉体製造方法を実現する装置は、 高速気流式分級機から排出される気流中に含まれる粉体 30 に、レーザ光を照射する設備か或いは、マイクロ波によ り加熱する設備を連結し、その後に乾式微粉捕集装置を 連結して構成される。また、高速気流式粉砕機と高速気 流式分級機を連結もしくは合体させ、該分級機から排出 される気流中に含まれる粉体に、レーザ光を照射する設 備か、或いは、マイクロ波により加熱する設備を連結 し、その後に乾式微粉捕集装置を連結して構成される。 前述のように、気流として用いるガスとしては、大気か 不活性ガスを使用できる構成となっている。

【0017】本発明により製造する電子デバイスは、主 40 には粉体を樹脂バインダの溶液に分散させてスラリーも しくはペーストの形態にして成形し、これを乾燥、硬化 させて特性を利用するようなものか、或いは同様に成形 した後、乾燥、脱バインダおよび焼成を行って特性を発 現させるという工法によって製造されるものであって、前者に属するものは電池、後者に属するものはセラミック電子部品、積層セラミックコンデンサ、多層配線基 板、モジュール部品およびプラズマディスプレイバネル である。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施の形態を、図面を参照しながら説明する。

【0019】(実施の形態1)図1に本発明の粉体製造方法および装置の実施の形態1を示す。原料は投入孔102から投入され、コンプレッサ或いはボンベ101からガスを導入される高速気流式粉砕機103中で粉砕される。粉砕された原料は導出管105を通って高速気流式分級機106に導かれ、ことで設定された粒径範囲の原料が導出管105に導かれると共に、粗粉は導出管10.4を通って再び気流式粉砕機103に戻される。これらの粉体処理システムは、例えば特許第3083769号公報や特開2000-317338号公報および特開平11-156224号公報等に開示され、市販されている装置を支障なく使用することができる。

【0020】次に、粉砕され、分級された原料は、気流と共にノズル109からバッグフィルタ等の乾式微粉捕集装置111に設けた吸入孔110に向かって噴射される際に、109と110の間に設けたギャップ部分で、レーザ光の発生装置107によって発生させたレーザ光20 を射出孔108から射出させることによって熱処理される。図中にはレーザ光の射出孔108として1つだけ示したが、粉体の種類や熱処理条件の設定のために複数の射出孔を設けても差し支えない。例えば、融点の高い物質からなる粉体を球状になるように熱処理する必要のある場合や、コスト等の関係で気流中の粉体濃度を高くする必要のある場合などには、複数の射出孔を設けたほうが好ましい。

【0021】多くの射出光を設けてより均一に照射、熱処理する場合にはファイバーによる導光技術が確立されているYAGレーザが適しているが、との場合にはレーザ出力の制限を受ける。また、前述のように異種のレーザを同時照射する場合にも、複数の射出孔を設けて行う。乾式微粉捕集装置111は、ブロワー112によって吸引され、熱処理された粉体は排出孔113から取り出される。

【0022】(実施の形態2)図2に本発明の粉体製造方法および装置の実施の形態2を示す。コンプレッサ或いはボンベ201、原料投入口202、高速気流式粉砕機203、導出管205および205、高速気流式分級機206等からなる粉体処理システムは、実施の形態1と同様のものである。粉砕され、分級された原料は、マイクロ波発信器207で発生させ、導波管208を通って加熱筒209中で放射されるマイクロ波によって加熱され、ブロワー211によって吸引されたバッグフィルタ等の乾式微粉捕集装置210の排出口212から取り出される。

【0023】(実施の形態3)図3に本発明の粉体製造方法および装置の実施の形態3を示す。コンプレッサ或いはボンベ301、原料投入口302、高速気流式粉砕50機303、導出管305および305'、高速気流式分

級機306等からなる粉体処理システムは、実施の形態1と同様のものである。本実施形態では、導出管305'と、ブロワー311によって吸引されたバッグフィルタ等の乾式微粉捕集装置310の間のレーザー照射部分に窓材309を設けた構造とし、粉砕され、分級された原料は、窓材309を通して入射するレーザ光によって加熱される。この窓材309は使用するレーザの波長によって、その材質が規定される。本実施形態は、レーザ光処理を大気以外の雰囲気中で行う必要のある粉体に対して適用される。実施の形態1と同様にレーザ光の射10出孔308は複数設けてもよく、この場合には窓材309もそれに応じて複数個具備される。処理された粉体は排出孔312から取り出される。

【0024】(実施の形態4)図4に本発明の粉体製造方法および装置の実施の形態4を示す。本実施形態は、粉砕、分級の装置を一体化して高速気流式粉砕分級機403としたものであって、この部分に使用できる市販の装置としてはこのタイプが一般的であり、扱うべき粉体の種類や目的とする粒子径等に応じて支障なく使うことができる。処理された原料粉体は排出孔411から取り出される。なお、本実施形態においても、粉体を加熱する方法として実施の形態2および3に記載した方法も適用できるのは言うまでもない。

【0025】また、本発明の微粉砕操作については、以上の実施の形態に示した乾式気流粉砕に限るものではないので、予め他の方法で微粉砕したものを処理する場合には、図5に示したように微粉砕操作部分を除いた形態であっても差し支えないが、前述のように気流中に粉体を効率良く分散させるという意味合いも持たせてあるので、過粉砕されない条件で運転させるのであれば、乾式 30気流粉砕装置を使用した実施の形態1から4の何れかの方が好ましい結果が得られる。図5の場合にも、粉体を加熱する方法として実施の形態2および3に記載した方法も適用できる。

【0026】以上の実施形態に示した粉体製造方法および装置において、粉体の搬送流量や濃度および加熱装置の出力等を適当に調整することにより、種々の粉体の結晶性向上や均質化、形状制御を行うことができる。適用できる粉体の材質としては、金属およびその化合物が代表的なものとして挙げられ、更に高分子化合物等の有機 40物質についても、その目的に応じて適用することができる。

[0027]

【実施例】以下に実施例を用いて本発明の効果について 詳しく説明する。

【0028】(実施例1)チタン酸バリウムを主成分と トを印刷、し、添加物としてジルコン酸ストロンチウム、酸化マン 層セラミッガン、酸化ディスプロシウム、炭酸バリウムおよび酸化 寸法は2.アルミニウムを、ジルコニアボールを媒体とするボール を脱バインミルで混合した誘電体組成物を、大気中1100℃で仮 50 焼成した。

焼し、この仮焼生成物を同様にボールミルで粉砕、誘電体組成物粉末を製造した。この際、レーザー回折式粒度分布径測定装置で粒度分布をモニターし、平均粒子径D50が1±0.2μmとなるように粉砕条件を調整した。比較のため、この段階で得られた誘電体粉末を原料Aとして抜き取った。

10

【0029】次にこの原料Aを、実施の形態1に示した装置で処理した。分級点の設定は 1μ mとし、加熱方法としては出力10kWの炭酸ガスレーザーを用い、処理量は1時間あたり約5kgとした。粉体を含む気流の、レーザーの焦点からの位置は、この粉体が加熱により揮散しない距離となるように調整した。このようにして得られた誘電体粉末を原料Bとした。

【0030】これらの操作を、同一組成、同一条件で個別に5回行い、原料Aおよび原料Bについて、それぞれ5ロットの誘電体組成物原料を作成した。

【0031】このようにして得られた各ロットの原料Bの粒度分布は、原料Aに比べると、最大粒子径が約 9μ mから約 3μ mに減少し、分布としてはシャープになっていることが確認された。また、原料Bの粉体を走査型電子顕微鏡で観察すると、ペロブスカイト相の晶癖が見られるものの、ほぼ球形に近い多角形となっていることが認められ、更に、X線回折測定によりペロブスカイト相単相からなり、他の結晶相や非晶質相は含有されていないことが確認された。

【0032】次に、ブチラール樹脂をブチルカルビトー ルと酢酸ブチルの混合溶剤に溶解したビヒクルに、誘電 体組成物原料を分散させスラリーを作成した。分散には 前述と同様にボールミルを使用した。このスラリーを離 型処理したPETフィルム上にダイコーターを用いて塗 布し、乾燥してグリーンシートとした。各原料ロットに ついて全く同条件でグリーンシートを作成したが、それ らの膜厚を測定したところ、原料Aの5ロットについて は12.0 µm~13.2 µmの範囲であり、同様に原 料Bについては12. 2 μm~12. 5 μmの範囲であ った。また、1 c m' あたりの誘電体量を熱重量分析で 求めたところ、原料Aについては3.43mg~3.6 5mgであり、原料Bについては3.51mg~3.5 5mgの範囲であることが分かり、原料Aより原料Bの 方がグリーンシートの特性のロット間変動が小さいこと が明らかとなった。スラリーの粘性については評価しな かったが、このことから原料Bを用いたスラリーは、原 料Aのスラリーよりもロット間の粘性特性が安定してい たと考えられる。

【0033】 これらグリーンシート上にニッケルベーストを印刷、乾燥した後、熱プレスで積層し、寸断して積層セラミックコンデンサの生チップを作成した。寸断の寸法は2.5 mm×1.5 mmとした。これら生チップを脱バインダし、還元雰囲気中、最高温度1300℃で低成した

【0034】ここで、原料AおよびBの各ロット約20 00個中から20個ずつの焼成チップを抜き取って寸法 を測定したところ、原料Aから作成した焼成チップで は、長手方向が1.94mm~2.08mmで幅方向が 1. 17mm~1. 25mmであったのに対し、原料B から作成したものでは、1.97mm~2.02mmと 1. 19mm~2. 02mmであった。これによって原 料Bの方が、焼成収縮率においてもロット間変動が小さ くなっていることが分かった。

【0035】次に、焼成チップをSiC粉末を媒体とし て遊星ミル中で面取りし、電極取り出し端子としてCu ペーストを塗布、窒素雰囲気中で焼成して積層セラミッ クコンデンサを完成した。これらの電気特性をLCRメ ータと絶縁抵抗計で評価した。容量の温度特性は、いず れのロットについてもJISのF特性を満足した。測定 温度20℃における容量値は、各ロットについて100 個のデータを取り、原料Aによる積層セラミックコンデ ンサでは89nF~115nFであり、原料Bによるも のでは94nF~103nFであった。また、同様に5 0 Vで測定した絶縁抵抗の値は、原料Aについては8. 0×10°Ω~3.3×10°Ω、原料Bについては 1. 9×10¹⁰ Ω~4. 5×10¹⁰ Ω であった。 このよ うに、グリーンシートの特性バラツキが小さい原料Bか ら作成したコンデンサでは、電気的な特性についてもそ のバラツキが小さくなった。

【0036】生チップの焼成時、最高温度を変えて焼結 状態や電気特性を評価したところ、原料Aによる生チッ プでは最高温度を1260℃まで下げたときに、ロット によっては燒結しないものが現れたのに対し、原料Bの ものでは1220℃まで焼結状態のバラツキはなく、1 200℃で全ロットが焼結不充分となった。従って、原 料Bを使うことによって実質的に焼成温度を1220℃ 程度まで低下させることができると言える。

【0037】本実施例では酸化物粉体を処理したので、 吸収率等の点から炭酸ガスレーザーを用いた。しかしな がら特に本実施例で用いた強誘電体のような誘電損失の 大きい材料の場合、マイクロ波加熱も有効であり、実施 の形態2に示した装置を用いても本実施例に示したのと 同じ効果が得られた。

【0038】また、本実施例では原料粉体の微粉砕をボ 40 ールミルによって予め行ったが、これは従来法との比較 という観点からのサンプルを得るのが目的であったため であり、量産時においては仮焼後の解砕粉末を、そのま ま実施の形態1に示した装置に投入して行うのがより一 般的である。

【0039】本発明は、加熱によって分解しないもので あれば他の酸化物系にも適用することができ、従って本 実施例のような積層セラミックコンデンサだけでなく、 バリスタ、サーミスタ、フィルター、コイルなどのセラ

性バラツキが小さく、製造歩留りの高い製品を得ること ができる。また、基板や碍子等に多用される絶縁性セラ ミックの原料、例えばアルミナ、フォルステライトなど にも適用することができる。なお、本実施例では粉末を スラリー化し、グリーンシートを経て製品を成形する例 を示したが、揮発性の低い溶剤を用いて印刷ペーストを 作成し、これを用いて成形する場合にも同様な効果が得 られる。

12

【0040】(実施例2)水熱合成し、仮焼して平均粒 子径を0.2μmとしたチタン酸バリウム粉末を、実施 の形態4に示した装置で処理した。加熱処理は、10k ₩の炭酸ガスレーザーを用い、実施例1と同様の条件で 行った。但し、本実施例の場合はレーザーの焦点からの 距離を実施例1よりも遠い位置に設定し、粉体の溶融が 起こらないようにした。SEM観察により、処理前と処 理後の粉体を比較したところ、両者の大きさや形状には 大きな相違は認められなかった。処理したチタン酸バリ ウム粉末のX線回折パターンを測定し、処理前のものに ついてのデータと比較すると、ピーク位置には差異はな 20 く、各ピークの半値幅が処理したものの方が狭かった。 従って、処理により結晶性が向上したものと考えられ

【0041】エタノールと水を混合した溶媒に、オルト ケイ酸テトラエチル、硝酸カルシウム、硝酸バリウム、 硝酸マンガン、硝酸ディスプロシウムおよび硝酸マグネ シウムを溶解した溶液中に、前記処理したチタン酸バリ ウム粉末を分散させ、撹拌しながらアンモニア水で中和 した後、ボールミルで混合、その後乾燥させ、大気中4 00℃で加熱して誘電体組成物を作成し、これを原料B とした。比較のため、実施の形態4に示した装置で処理 していないチタン酸バリウム粉末を用いて、同様な組成 および操作で誘電体組成物を作成し、これを原料Aとし

【0042】実施例1と同様に、これら原料を用いてス ラリーを作成し、グリーンシートを成形した。厚みは双 方ともに5μmとした。これらグリーンシートにニッケ ルベーストを印刷し、乾燥した後、加熱プレスで積層、 圧着し、寸断して積層セラミックコンデンサの生チップ を作成した。脱バインダ、還元雰囲気中1275°Cでの 焼成の後、実施例1と同様に端子電極を設けて、積層セ ラミックコンデンサを得た。これらの電気特性を評価し たところ、原料Aから作成したものでは、容量温度特性 がJISのF特性とE特性の中間的な特性となり、絶縁 破壊電圧がDC5VからDC95Vであって、非常に大 きなバラツキを示した。これに対し、原料Bからのもの では、JISのB特性を満足し、絶縁破壊電圧もDC1 00VからDC125Vと安定した値を示した。研磨し て化学エッチングを施した断面のSEM観察から、原料 Aによる誘電体は焼結粒子径が2~8μmであるのに対 ミック電子部品の製造においても、本発明を利用して特 50 し、原料Bでは0.3~0.5μmと微細であることが 20

分かった。

【0043】このように、本発明によれば微細な粉末の 粒子径を変化させることなくその結晶性を高めることが でき、それによって焼結時の反応性を制御し、微細な粒 子からなる焼結体を得ることができる。チタン酸バリウ ムの場合、このような本発明の効果が実質的に得られる のは平均粒子径が0.3ミクロンに満たない粉体である 場合であって、平均粒子径が0.3ミクロン以上の粉体 の場合には、微細な粒子からなる焼結体を得るという観 点からは、必ずしも本発明を適用する必要はない。ま た、本発明が有効となる平均粒子径の上限は、他の材料 からなる粉体については、その物理化学的性質に応じて 変動するものである。

【0044】従って、本実施例に示した積層セラミック コンデンサのみならず、微細な粉末の結晶性を上げると とによって性能の向上が見こめるセラミック部品につい ても応用が可能である。

【0045】本実施例においては、炭酸ガスレーザーに よる加熱だけでなく、粉体を含む気流に対して互いに 1 20℃の角度をなして入射するように3つの射出孔40 5を配置したYAGレーザー(出力400♥)を用いて 加熱する方法も行ったが、前述と同様な結果が得られ た。

【0046】(実施例3)酸化アルミニウムと酸化カル シウムを副成分として含有するホウケイ酸ガラスを、溶 融法によって作成した。得られたガラス塊をハンマーミ ルで粗粉砕し、325メッシュのふるいを通したもの を、実施の形態4に示した装置で処理し、これをガラス 原料Bとした。加熱方法および条件は、実施例1と同様 とした。また、分級点は2μmに設定し、処理量は1時 間に約3kgで行った。従来法との比較のため、前記3 25メッシュのふるいを通した粉末を、乾式粉砕、分級 点2μmで分級したものも作成し、これをガラス原料Α とした。ロット間変動を調べるため、これらについても 実施例1と同様にそれぞれ5ロットずつ作成した。

【0047】レーザー回折式粒度分布計で両者の粒度分 布を比較すると、大きな差異は認められなかったが、S EM観察によるとガラス原料Aの方は角張った不規則な 形状であるのに対し、ガラス原料Bは球状もしくは角が 丸くなった多角形状であることが認められた。また、ガ 40 ラス原料Αでは、約0.3μm以下の微細粒子が存在 し、大きいサイズの粒子に付着しているのが多く見られ るが、ガラス原料Bではこのような微細粒子は観察され なかった。

【0048】ローソーダアルミナ(平均粒子径2μm) と前記ガラス原料を混合して実施例1と同様にスラリー とし、ガラスアルミナのグリーンシートを作成した。グ リーンシート厚みのロット間バラツキ範囲は、ガラス原 料Αを用いたものでは115μm~147μm、ガラス 原料Βを用いたものでは122μm~127μmであ

り、実施例1と同様に求めた1 c m'あたりのガラスセ ラミック量のロット間バラツキ範囲は、ガラス原料Aに よるものでは17.8mg~22.4mg、ガラス原料 Bによるものでは18.7mg~19.4mgであっ た。これから、本発明によるガラス原料Bの方が、グリ ーンシートの物性値バラツキが小さいことが分かった。 【0049】これらグリーンシートと配線、電極用の銀 ペーストを用いて、コンデンサを内蔵したモジュール部 品を作成した。配線層は両面で6層とし、配線層間の接 続はグリーンシートに200μmの孔をあけて吸引しな がら銀ペーストを埋め込む方法によった。内蔵するコン デンサはガラスアルミナ層1層おきに設けて督促3個と し、電極面積を変えることによって3種類の容量値とな るようにした。印刷、乾燥後、実施例1と同様に熱加圧 で積層し、13.0mm角に寸断した後、脱バインダ、 焼成してモジュール部品とした。焼成は大気中、最高温 度850℃のベルト炉によって行った。

【0050】焼成後の寸法のロット間バラツキ範囲は、 ガラス原料Aによるものでは9.5mm~11.0m m、ガラス原料Bによるものでは9.5mm~10.2 mmであった。また、内蔵した3種類のコンデンサの2 0℃、1MHzでの測定値のロット間バラツキは、ガラ ス原料Aによるものでは、それぞれ5.5pF~7.2 pF, 15. $9pF \sim 18$. 6pF, 40. $3pF \sim 4$ 7. 2pFであり、ガラス原料Bによるものでは同様 VC, 6. 3 p F \sim 6. 8 p F, 17. 5 p F \sim 18. 6 pF、44.8pF~47.1pFであった。このよう に、グリーンシートの物性値バラツキを反映して、本発 明にかかるガラス原料Bより作成したモジュール部品の 30 方が、寸法や電気的性質などの特性値のバラツキが小さ い。更に特性バラツキを抑制するには、使用するローソ ーダアルミナについても、実施の形態4に示した装置で 処理し、その粒度分布と形状を制御するのが望ましい。 【0051】本実施例では、ガラスとしてホウケイ酸ガ ラス、フィラーとしてアルミナを用いたが、誘電率や誘 電損失といった電気的特性や抗折強度や熱衝撃特性とい った機械的性質を満足させるために、他の酸化物ガラス 系や結晶化ガラス系を用いてもよく、フィラーとしても フォルステライトやムライトといった絶縁性酸化物やチ タン酸塩に代表される強誘電性酸化物等を用いることが できる。

【0052】また、本実施例では3種の容量値を設定し たコンデンサ部を内蔵させたモジュール部品を作成した が、本発明は、要求特性に応じてフィルターや発振子を 内蔵させたモジュール部品、或いは半導体パッケージの ような多層配線基板の製造にも適用することができ、特 性バラツキが小さく、歩留りの良い製品を製造すること ができる。

【0053】(実施例4)酸化亜鉛と酸化カルシウムを 50 副成分として含有するホウケイ酸鉛ガラスを、溶融法に よって作成した。実施例3と同様の方法で、実施の形態4に示した装置で処理し、これをガラス原料Bとした。従来法との比較のため、実施例3と同様に乾式粉砕、分級したものも作成し、これをガラス原料Aとした。ガラスの組成は、その軟化点が530℃となるように調製した。両者の原料の粒度分布はほぼ同じで、SEM観察によって、粉末形状がガラス原料Bではほぼ球形に近く、ガラス原料Aでは実施例3と同様に角張って不規則であることを確認した。

【0054】これらA、Bのガラス原料を、エチルセル 10 ロースをタービネオールと石油ナフサの混合溶媒に溶解したビヒクルに、3本ロールミルで分散させ、フタル酸エステル(BBP)を添加して2種類の絶縁層用ペーストを作成した。また、これらガラス原料とフィラーとしてのジルコニアおよびアルミナ粉末を混合して同様に混練し、2種類のリブ形成用ペーストを作成した。

【0055】ITO透明電極をストライプ状に形成したガラス基板に、酸化ルテニウムと銀を混合したベーストと銀ベーストをストライブ状に印刷、焼成してバス電極とした。更にブラックストライブを印刷、焼成した後、前記絶縁層用ベーストを基板全面にスクリーン印刷し、乾燥して焼成した。次に、この絶縁層上に酸化マグネシウムを蒸着形成して42インチのブラズマディスプレイパネル(以下、PDPと記す)の前面板を作成した。

【0056】ガラス基板上に銀ペーストをストライプ状 に印刷、焼成してデータ電極とした。この上に前記絶縁 層用ペーストを基板全面にスクリーン印刷し、乾燥、焼 成して絶縁層を形成した。データ電極間に、前記リブ形 成用ペーストをストライプ状に都度乾燥しながら印刷積 層、焼成してリブを形成し、リブ間にR、G、Bの蛍光 30 体ペーストをストライプ印刷し、焼き付けてPDPの背面板を作成した。

【0057】前面板と背面板を位置合わせして封着し、 排気した後ネオンとキセノンの混合ガスを封入して、4 2インチの評価用PDPを得た。言うまでもなく、ガラ ス原料Aを用いた絶縁層用ペーストとリブ形成用ペース トによるものと、ガラス原料Bを用いたペーストによる ものの2種類を作成し、ドライバー等を接続して点灯試 験を行った。その結果、ガラス原料Aを用いたペースト から作成したパネルでは約100個の点灯しないセルが 40 あったのに対し、ガラス原料Bを用いたものでは0個で あった。また、前者ではパネルの周辺部分と中央部で輝 度が異なるムラが見られたが、後者ではこのようなムラ はなかった。点灯試験後、これらのパネルを分解し、ガ ラス原料Aを用いたものについて不良箇所の分析を行っ たところ、不点灯のセル部分では絶縁層の大きな気泡の 存在による絶縁破壊やリブの欠けが生じていることが分 かった。

【0058】また、絶縁層やリブの厚み分布(パネル全 成分とする溶媒にヘキサフルオロリン酸リチウムを溶解面にわたって16点をサンプリングして測定)は、ガラ 50 させた電解液を注入して、設計容量値1600mAhの

ス原料Aを用いた絶縁層用ペーストによるパネルでは、 37μ m~ 45μ m、ガラス原料Aを用いたリブ用ペーストによるパネルでは、 108μ m~ 133μ mであったのに対し、ガラス原料Bを用いたペーストによるパネルでは、それぞれ 40μ m~ 42μ mおよび 117μ m~ 122μ mであった。このように、本発明によるガラス原料Bを用いたペーストにより、特性パラツキと不良の少ないPDPが製造できる。

【0059】また、本発明によれば、厚みバラツキを小さく、絶縁層中の残存気泡を少なくできるので、前記絶縁層の実質的な設計厚みをより薄くすることができ、従って放電電圧を下げて消費電力を削減することも可能である。また、より表示品質を向上させ、同時に歩留りを向上させるために、本実施例で用いた蛍光体ペーストに用いる粉末に対して本発明を適用したり、電極を形成する銀などの導電体粉末に本発明を適用して、それぞれペーストを作成して使用してもよい。更に、リブ形成用ペーストに用いるフィラー粉末に対しても、本発明を適用すればリブ高さのバラツキやリブ欠けなどにおいてより良い結果が得られる。

【0060】(実施例5)炭酸リチウムと水酸化コバルトをモル比で1.07:1.00となるように配合し、乾式混合した後、大気中950℃で仮焼し、これを解砕、粗粉砕してリチウム過剰のコバルト酸リチウム粉末を作成した。これを、分級点10 μ mに設定した実施の形態4に示した装置で処理し、活物質Bとした。加熱には出力10kWの炭酸ガスレーザーを用い、処理量は1時間に約6kgで行った。また、比較のため前記粗粉砕粉を乾式粉砕し、同様に分級点10 μ mで分級した粉末も作成し、これを活物質Aとした。SEM観察により活物質Aと活物質Bを比較すると、実施例1と同様の結果であることが確認された。ロット間バラツキを調べるため、いずれの活物質についても同様な操作で5ロットずつ作成した。

【0061】両者の活物質とアセチレンブラックを混合し、ボリフッ化ビニリデンをNーメチルー2ービロリドンに溶解したビヒクルに分散させてスラリーを作成し、アルミニウム箔上に塗布、乾燥後、ローラー圧延してリチウムイオン電池の正極板を作成した。この際、各ロットから作成した活物質層の厚みバラツキを調べたところ、活物質Aから作成したものでは±11%であったのに対し、活物質Bから作成したものでは±2%であった

【0062】これとは別に、同一ロットの黒鉛粉末と前記ビヒクルからスラリーを作り、銅箔上に塗布、乾燥、圧延して負極板を作成した。これらの極板を用い、通常の方法でセパレータと共に捲回し、ケースに装填した後、エチレンカーボネートとジメチルカーボネートを主成分とする溶媒にヘキサフルオロリン酸リチウムを溶解させた電解液を注入して、設計容量値1600mAhの

円筒型リチウムイオン電池を同一の条件で作成し、特性 を測定した。

17

【0063】各ロットの正極板から作成した電池10個 について、25°Cで4.1V、1.6Aの充電、カット オフ電圧を2.75∨とした1.6Αの定電流放電を繰 り返す充放電サイクル試験を行い、容量のバラツキ、容 量保持率のバラツキなどを測定した。その結果、活物質 Aから作成した電池では、初期容量のロット間バラツキ が1430mAh~1690mAhであったのに対し、 活物質Bによる電池では、1600mAh~1620m 10 Ahであった。また、500サイクル後の容量保持率の ロット間バラツキは、活物質Aによる電池で55%~7 8%であったのに対し、活物質Bによるものでは79% ~82%であった。

【0064】このように、本発明によって作成した活物 質を使用すると、製造ロットによる特性バラツキの小さ いリチウムイオン電池を製造することができる。これ は、活物質粒子の形状および表面状態等が安定化するた めに、スラリー物性および活物質層の厚み、構造、充填 率、バインダ樹脂の分布等、電池特性に影響を与える物 20 できる。このような効果は気相還元法によるニッケル粉 性値が安定となるからである。

【0065】本実施例では、典型的な例としてコバルト 酸リチウムで実施したが、ニッケル酸リチウム系やマン ガン酸リチウム系およびそれらの固溶体を用いても、特 性安定性という観点で同様な効果が得られる。また、搬 送する気流として窒素を用いて遷移金属硫化物を処理す ることにより、本実施例と同様な特性の安定した電池が 実現可能である。なお、本発明は、活物質として酸化物 や硫化物或いは金属粉体を用いて極板が製造されるもの であれば、本実施例に示したリチウムイオン電池に限定 30 されるものではなく、他の電池系に対しても同様な効果 を与えるものである。

【0066】(実施例6)液相還元法で作成したニッケ ル粉末 (平均粒子径0.15 μm) を、実施の形態3 に 示した装置で窒素気流中で処理した。この際、窓材とし てセレン化亜鉛を用いて出力10kWの炭酸ガスレーザ によって加熱処理を行った。このようにして作成したニ ッケル粉末を原料Bとし、比較のためにこの処理を行っ ていない液相還元法で作成したニッケル粉末を原料Aと した。これら原料粉末をSEM観察した結果、原料Aは 40 不規則な形状を持った粉体であるのに対し、原料Bでは 多面体もしくは球状の形状を持った粉体であることが分 かった。

【0067】これらA、Bのニッケル粉末原料を、エチ ルセルロースをターピネオールと石油ナフサの混合溶媒 に溶解したビヒクルに3本ロールミルで分散させ、内部 電極ペーストを作成した。実施例2で製造した誘電体原 料Bを用いたグリーンシートに、これら内部電極ペース トを印刷厚みを変えて印刷、乾燥した。この際、内部電 極層1 c m' あたりのニッケル重量(以下、塗着重量と

呼ぶ)を、測定、評価した。

【0068】次に、実施例2と同様の方法で積層セラミ ックコンデンサを作成し特性の評価を行った結果、原料 Aから作成した内部電極ペーストによる積層セラミック コンデンサでは、塗着重量が1.0mgから0.8mg のサンプルの容量バラツキが±5%、同様に0.8mg から0.65mgのサンプルで $\pm 40\%$ 、0.65mg より少ないサンプルで容量が得られなかったのに対し、 原料Bによる内部電極ペーストによるものでは、塗着重 量が1.0mgから0.65mgのサンプルの容量バラ ツキが±5%、同様に0.65mgから0.5mgのサ ンプルで±40%、0.5mgより少ないサンプルで容 量が得られなかった。即ち、原料Bによる内部電極ペー ストを用いた方が、塗着重量が少なく、実質的に内部電 極の厚みが小さい積層セラミックコンデンサを安定に製 造できるととが分かった。

18

【0069】従って、本発明による内部電極ペーストに よれば、1層あたりの厚みが小さく高積層の積層セラミ ックコンデンサを特性バラツキを小さく製造することが 末を用いても得ることができるが、本実施例のポイント は安価な液相還元法によるニッケル粉末を加工すること によって同等の効果を得るという点にあり、本発明は積 層セラミックコンデンサの高容量化だけでなく、低コス ト化に対して有効である。

【0070】なお、本実施例では積層セラミックコンデ ンサの内部電極としてニッケル粉末について述べたが、 本発明は、配線や電極材料として多用される金、銀、 銅、パラジウムおよび銀パラジウム合金等の粉末につい ても、低コスト化と高精度化や低抵抗化といった高性能 化の観点で有効であって、実施例3や実施例4に述べた ような電子デバイスにも適用できる。また、本発明は、 特に金と銀の粉末について、焼成型ではない溶剤乾燥型 や樹脂硬化型の導電ペーストにも適用することができ、 部品実装や面実装型の部品、メンブレンスィッチ、樹脂 多層基板および電解コンデンサなどの製造にも応用する ことができる。

[0071]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明の粉体製造 方法および装置によれば、粉砕、分散、分級を気流中で 行うと共に、連続してレーザかマイクロ波を照射して、 粉体粒子1つずつを効率良く加熱処理することができ、 粒度分布、形状、表面状態等の安定した粉体を製造でき る。これによって、製造歩留りや性能等の安定した電子 デバイスを提供することができ、粉体製造分野と電子デ バイス製造分野における効果は大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の粉体製造方法および粉体製造装置の実 施の形態1を示すブロック図

【図2】本発明の粉体製造方法および粉体製造装置の実

施の形態2を示すブロック図

【図3】本発明の粉体製造方法および粉体製造装置の実施の形態3を示すブロック図

19

【図4】本発明の粉体製造方法および粉体製造装置の実施の形態4を示すブロック図

【図5】本発明の粉体製造方法および粉体製造装置の他の実施形態を示すブロック図

【符号の説明】

101, 201, 301, 401, 501 コンプレッサーもしくはボンベ

102, 202, 302, 402, 502 原料投入口

103, 203, 303 高速気流式粉砕機

104, 204, 304, 105, 105', 205,

205', 305, 305', 406, 504 導出管 *

*106, 206, 306, 503 高速気流式分級機

107,307,404,507 レーザ光の発生装置

20

108, 308, 405, 506 レーザ光の射出孔

109, 407, 505 ノズル

110, 408, 508 吸入孔

111, 210, 310, 409, 509 乾式微粉捕 集装置

112, 211, 311, 410, 510 ブロワー

113, 212, 312, 411, 511 排出口

10 207 マイクロ波発信器

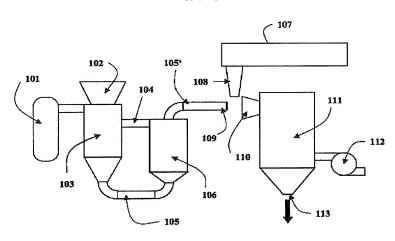
208 導波管

209 加熱筒

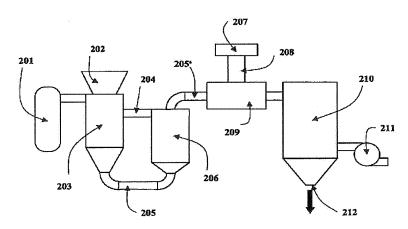
309 窓材

403 高速気流式粉砕分級機

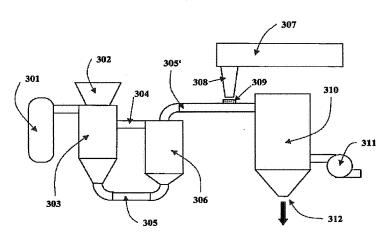
【図1】



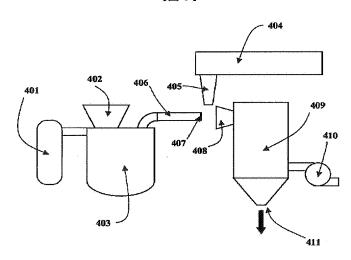
[図2]



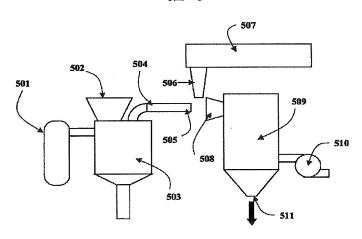
[図3]



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号	FI		テーマコード(参考)
H01G	4/12	361	H01G	4/30	311Z 5E346
	4/30	3 1 1	H 0 1 M	4/04	A 5H050
H 0 1 M	4/04			4/58	
	4/58		H 0 5 K	3/46	Ĥ
H05K	3/46		C 0 4 B	35/46	D
// C04B	35/46			35/00	В

(72)発明者 白石 誠吾

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 田井 伸幸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

產業株式会社内

F ターム (参考)	4D067	CA02	CA03	EE07	EE22	EE32
		GA07	GA08	GA10	GB10	

4G030 AA09 AA10 AA11 AA16 AA17 AA25 AA36 BA09 CA01 CA04 CA08 GA01 GA03 GA08 GA14

GA17 GA20 GA26 GA27

4G031 AA05 AA06 AA07 AA11 AA12

AA19 AA29 BA09 CA01 CA04

CA08 GA03 GA04 GA10 GA11

5E001 AB03 AC10 AE02 AH01 AH09

AJ01 AJ02

5E082 AB03 FF05 FG04

5E346 AA12 AA15 AA38 BB01 CC18

CC31 DD02 DD34 EE24 EE29

GG03 GG04 HH33

5H050 AA19 BA16 BA17 CA08 CA09

DA04 DA10 DA11 EA08 GA02

GA03 GA05 GA10 GA22 GA27

GA29